

Я, Панасенко Петр Васильевич, даю согласие быть оппонентом по диссертации Карпова Вадима Николаевича на тему «Способ сжатия сигналов в многоканальных радиосистемах с аналого-информационным преобразователем», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.2.13 – Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения

Сведения об оппоненте

Фамилия, имя отчество официального оппонента	Панасенко Петр Васильевич
Учёная степень	доктор технических наук
Учёное звание	профессор
Наименование отрасли науки и научной специальности, по которой оппонентом защищена диссертация	05.27.01 – Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нано- электроника, приборы на квантовых эффектах
Полное наименование организации, являющейся основным местом работы официального оппонента	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники»
Занимаемая в организации должность, с указанием структурного подразделения	Заместитель генерального директора АО «НИИМЭ»
Адрес организации основного места работы официального оппонента	124460, Россия, Москва, Зеленоград, ул. Академика Валиева, д.6, стр. 1
Телефон (с кодом города), адрес электронной почты и адрес сайта организации основного места работы официального оппонента	Телефон организации: +7 495 229 7000 E-mail организации: niime@niime.ru Web-сайт организации: https://www.niime.ru
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Влияние дополнительного диэлектрического слоя и заземленного экрана на высокочастотные характеристики элементов GaAs микросхем в 3D-интегрированных модулях / Ф. И. Шеерман, Н. В. Голенева, А. А. Кокотов [и др.] // Радиотехника и электроника. – 2025. – Т. 70, № 1. – С. 27-36. 2. Анализ приборных требований к гетероэпитаксиальным структурам AlGaN/GaN на Si для силовой и СВЧ ЭКБ / Г. В. Баранов, А. О. Беляев, А. А. Дорофеев [и др.] // Электронная техника. Серия 3: Микроэлектроника. – 2022. – № 4(188). – С. 5-17. 3. Исследование зависимости высокочастотных характеристик схем на основе КМОП КНИ-технологии «90 нм» от параметров конструкции межсоединений транзисторов / А. А. Мошаров, Г. В. Баранов, С. С. Гусев [и др.] // Электронная техника. Серия 3: Микроэлектроника. – 2025. – № 2(198). – С. 32-40. 	

4. Исследование влияния конструкции межсоединений транзисторов в КНИ технологии "90нм" на ВЧ характеристики / А. А. Мошаров, Г. В. Баранов, С. С. Гусев [и др.] // Электроника и микроэлектроника СВЧ. – 2024. – Т. 1. – С. 44-48.
5. Исследование тенденций развития конструкций силовых вертикальных GAN-транзисторов / А. О. Беляев, Г. В. Баранов, А. А. Дорофеев, П. В. Панасенко // Наноиндустрия. – 2025. – Т. 18, № S11-3(135). – С. 930-935.
6. Исследование проблем теплового распространения в малогабаритных СВЧ приемо-передающих модулях АФАР / М. Д. Пяточкин, П. В. Панасенко, Г. В. Баранов // Наноиндустрия. – 2025. – Т. 18, № S11-3(135). – С. 936-939.

Верно. Д.т.н., профессор, заместитель генерального директора АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники»

 П.В. Панасенко

Приведенные сведения и подпись д.т.н., профессора Панасенко П.В.

«Заверяю»

Начальник ОУП АО «НИИМЭ»



 М.В. Лизавенко